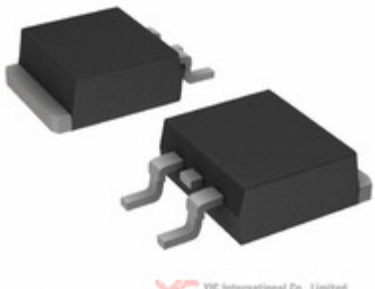
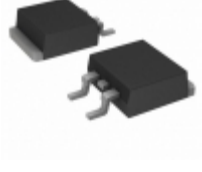







	<p>SQD45N05-20L-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD45N05-20L-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 50A TO252</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD45N05-20L-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 50A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SQD45N05-20L-GE3 ist neu im Original, Suche SQD45N05-20L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQD45N05-20L-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQD45N05-20L-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQD40P10-40L_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 100V TO252</p>	 <p>SQD40P10-40L-GE3 VB SQD40P10-40L-GE3 VB</p>	 <p>SQD45P03-12 VISHAY SQD45P03-12 VISHAY</p>	 <p>SQD40N10-25_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A TO252</p>
 <p>SQD45P03-12_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 50A TO252</p>	 <p>SQD45P03-12_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A TO252</p>	 <p>SQD40P10-40L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 100V TO252</p>	 <p>SQD45N05-20L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 50V 50A TO252</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SQD30N05-20L-GE3	↔ SQD35JA140	⇒ SQD35JA160	D SQD35N05-26L-GE3	⇒ SQD35N05-26L-GE3
⊖ SQD400A60	⊕ SQD400A60N	D SQD400A60S	⇒ SQD400A60S/	⇒ SQD400AA-120
⊕ SQD400AA100	⊖ SQD400AA120	⊕ SQD400AA60	↔ SQD400BA60	⇒ SQD40N04-10A-GE3
D SQD40N06-14L	⊕ SQD40N06-14L-GE3	⊖ SQD40N06-14L_GE3	⊕ SQD40N06-14L_GE3	⇒ SQD40N06-25L-GE3
⇒ SQD40N06-25L-GE3	↔ SQD40N10-25	⊕ SQD40N10-25-GE3	⊖ SQD40P10-40L-GE3	⇒ SQD45N05-20L-GE3
↔ SQD45P03-12	⇒ SQD45P03-12-GE3	D SQD50A100	⊕ SQD50A60	⊖ SQD50A90
⊕ SQD50AA100	D SQD50AB100	⇒ SQD50AB90	↔ SQD50B90	⇒ SQD50BA100
⊖ SQD50BB75	⊕ SQD50BB90	↔ SQD50CB100	⇒ SQD50DB100	⇒ SQD50N02-04-GE3
⊕ SQD50N03-06P-GE3	⊖ SQD50N03-09-GE3	⊕ SQD50N03-4M3	D SQD50N04-09H-GE3	⇒ SQD50N04-09H-GE3
↔ SQD50N04-3M5L	⊕ SQD50N04-4M1	⊖ SQD50N04-4M5L	⊕ SQD50N04-5M0-GE3	⇒ SQD50N04-5m6-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited